

УДК 535.37

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК

Г. М. Бурлак, Л. Н. Вилинская

Государственная академия строительства и архитектуры,
ул. Дирихсона 4, Одесса, Украина, 65029. тел. 8 (048) 7 -206-743.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК

Г. М. Бурлак, Л. Н. Вилинская

Аннотация. Приведены результаты экспериментального изучения влияния pH электролита на интенсивность люминесценции полупроводниковых пленок в контакте с электролитом. Показана возможность создания люминесцентных сенсоров перекиси водорода на основе полупроводниковых пленок.

Ключевые слова: люминесценция, сенсоры, растворы электролита

ВПЛИВ ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВОК

Г. М. Бурлак, Л. Н. Вілінська

Анотація. Наведено результати експериментального вивчення впливу pH електроліту на інтенсивність люмінесценції напівпровідникових плівок в контакті з електролітом. Показано можливість створення люмінесцентних сенсорів перекису водню на основі напівпровідникових плівок.

Ключові слова: люмінесценція, сенсори, розчини електроліту

THE INFLUENCE OF PEROXIDE HYDROGEN ON INTENSITY OF SEMICONDUCTOR FILMS LUMINESCENCE

G. Byrlak, L. Vilinskaya

Abstract. The results of experimental studying influence of electrolyte pH on intensity of a luminescence of semiconductor films in electrolyte are presented. The opportunity of creation of luminescent sensors of peroxide hydrogen on the basis of semiconductor films is shown.

Keywords: luminescence, sensors, electrolyte

Ранее [1] показано влияние природы электролита на интенсивность свечения ряда люминофоров в контакте с электролитом. Известно [2], что оксидные пленки алюминия перспективны для разработки сенсоров с высокой механической и термической стабильностью. Выбор H_2O_2 в качестве растворенной примеси в воде обусловлен его перспективным с экологи-

ческой и экономической точек зрения использованием как окислителя многих органических веществ [3]. Представляет интерес выяснить влияние концентрации перекиси водорода растворенной в водных растворах на интенсивность люминесценции некоторых люминофоров, погруженных в эти растворы.

В качестве основы люминесцентного сен-

сопа использовались люминесцентные структуры Al-Al₂O₃ и полупроводниковые пленки CdS. Оксидные пленки алюминия, получались электрохимическим окислением алюминиевой фольги в водном растворе (0,5-1%) щавелевой кислоты. Напряжение формовки составляло 30-70 В, время формовки 40-90 минут, что позволяло получать пленки толщиной 30-50 мкм. Одним из электродов к пленке Al₂O₃ служила алюминиевая фольга. В качестве второго электрода использовались слои SnO₂, нанесенные на окисную пленку методом пиролиза SnCl₄ [4]. Полупроводниковые пленки CdS напылялись в квазизамкнутом объеме на стеклянную подложку с проводящим слоем SnO₂. Используемый метод позволял получать слои крупнозернистые и с развитой поверхностью.

Поскольку интенсивность люминесценции была незначительной, то к образцам прикладывалось переменное напряжение с амплитудным значением недостаточным для возбуждения электролюминесценции, но обеспечивающее поступление ионов электролита к поверхности полупроводника. Предварительно определялась интенсивность люминесценции рассматриваемых люминофоров в определенных (фоновых) электролитах. В качестве фонового электролита использовался 3% водный раствор NaCl. После этого в электролите создавалась концентрация перекиси водорода. Измерялись изменения интенсивности люминесценции под влиянием перекиси водорода в температурном интервале 5 ÷ 80 °C. Люминесценция регистрировалась фотоумножителем, работающим в интегральном режиме.

На рис. 1 представлены зависимости интенсивности свечения пленок CdS в электролите от напряжения при различных концентрациях перекиси водорода. Установлено, что добавление в электролит перекиси водорода при концентрациях порядка от 10⁻¹¹ до 10⁻³ моль/л приводит к уменьшению интенсивности люминесценции пленок CdS. Порог чувствительности уменьшается с ростом температуры и при комнатной температуре составляет 10⁻¹¹ моль/л. Наблюдаемая зависимость может быть объяснена тем, что добавление перекиси водорода приводит к изменению соотношения концентрации ионов H⁺ и OH⁻ в электролите, т.е. происходит понижение величины pH, что в свою очередь приводит к уменьшению интенсивности люминесценции.

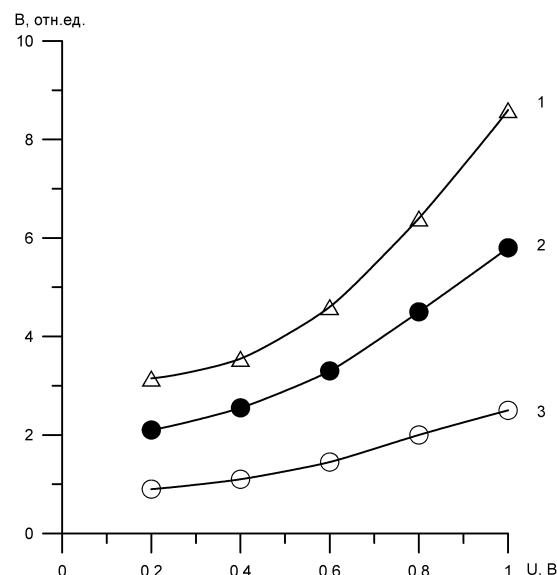


Рис. 1. Зависимость интенсивности свечения пленок CdS от напряжения в электролитах с различной концентрацией перекиси водорода: 1 — фоновый электролит (3% водный раствор NaCl), 2 — 10⁻⁷ моль/л, 3 — 10⁻³ моль/л.

На рис. 2 представлены зависимости яркости свечения пленок Al₂O₃ и CdS от величины водородного показателя (pH) среды. Зависимость B=B(pH) для сульфида кадмия и оксида алюминия представляет собой кривую с максимумом, который расположен при pH=7 (рис.2, кривая 1, кривая 2 соответственно).

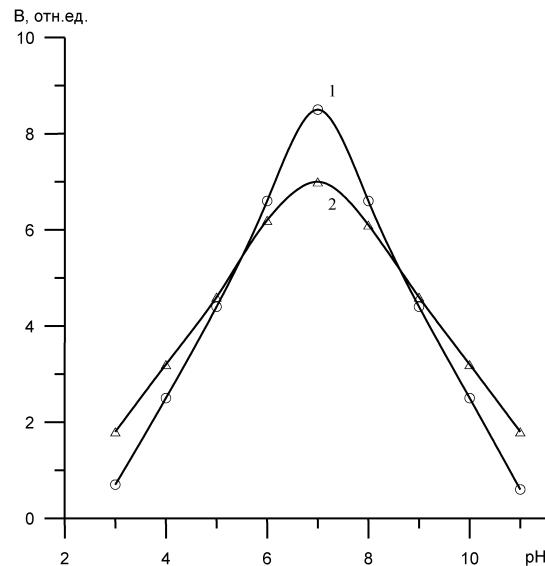


Рис. 2. Зависимость яркости свечения от величины pH электролита: 1 — CdS; 2 — Al₂O₃.

Зависимости B=B(pH), проходящую через максимум можно объяснить следующим образом. К поверхности исследуемой пленки по-

тупают ионы H^+ и OH^- . Так как из-за существования неоднородности поверхности пленки (например, пленка окиси алюминия) ионы Al^{3+} и гидроксильных групп OH^- , могут создаваться различные изолированные гидроксильные центры, которые имеют в свою очередь, различную локальную плотность заряда [5]. Аналогично происходит и взаимодействие ионов O^{2-} и H^+ . Было установлено [1], что на гидратированной поверхности окиси алюминия ион-радикалы OH^- и H^+ создают систему примесных уровней, соответственно выполняющих функции заполненных электронами ловушек и акцепторов с локализованными на них дырками, энергетическое расстояние которых от соответствующих зон составляет величину от 0.1 до 1 эВ.

Поступающие из электролита ионы H^+ адсорбируются на имеющих отрицательный заряд атомах серы поверхности пленки CdS или на атомах кислорода в случае пленки Al_2O_3 . В результате взаимодействия между люминофором и адсорбированными ионами H^+ происходит заброс электронов из валентной зоны на адсорбированные уровни и образование дырок в валентной зоне (Рис.3, переход 1). Свободная дырка захватывается на центры свечения, приводя к изменению зарядового состояния последнего (Рис.3, переход 2) и далее происходит десорбция нейтральных радикалов H .

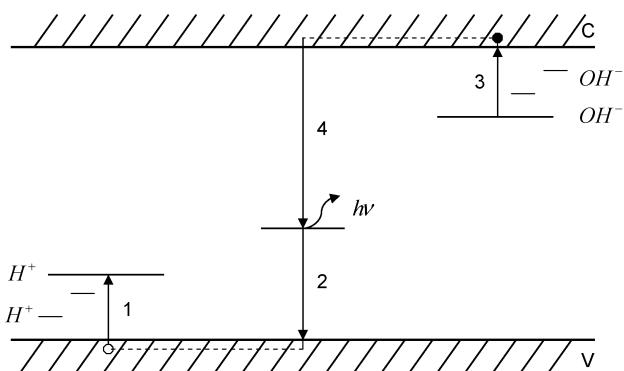


Рис. 3. Электронные переходы при возбуждении люминесценции пленок сульфида кадмия в электролитах.

Поступающие из электролита ионы OH^- адсорбируются на выступающих на поверхности фосфора и имеющих избыточный положительный заряд атомах Al для пленок Al_2O_3 . В результате взаимодействия между адсорбированными OH^- группами и твердым телом может происходить заброс электрона с примесного центра в зону проводимости (Рис.3, переход 3).

Нейтральный радикал OH десорбируется с поверхности, а образовавшийся свободный электрон захватывается на центр свечения с измененным зарядовым состоянием (Рис.3, переход 4), где рекомбинирует с излучением света.

Таким образом, в связи с тем, что за свечение ответственны в равной мере как ионы H^+ , так и OH^- , то при малых значениях pH (при $pH < 7$), когда концентрация ионов OH^- значительно меньше чем H^+ , свечение определяется концентрацией ионов, которых меньше, то есть OH^- , и с ростом pH яркость свечения увеличивается. При больших значениях pH (при $pH > 7$), когда концентрация H^+ значительно меньше OH^- , интенсивность свечения обуславливается концентрацией ионов H^+ , и яркость свечения с увеличением величины pH уменьшается. Очевидно, в этом случае зависимость $B=B(pH)$ должна проходить через максимум, что в действительности и наблюдается.

Таким образом, показано влияние концентрации перекиси водорода растворенной в водных растворах на интенсивность люминесценции некоторых люминофоров, погруженных в эти растворы. Приведенные результаты позволяют создать сенсоры для измерения концентрации перекиси водорода в водных растворах.

Литература

- Михо В.В., Денисова Г.М., Тоцкая А.В. Исследование люминесценции пленок Al_2O_3 в электролите // Химическая физика — 1992. — Т.11, №9. — С. 1232-1234.
- Куданович О.Н., Полевская Л.Г. Разработка сенсоров с использованием микроэлектронной технологии на основе анодного оксида алюминия // 3-я Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка й мікросистемні технології”(СЕМСТ-3), 2-6 червня 2008 г, Одеса — С.295.
- Покуца А.П., Заборовский А.Б., Максим Д.С. Каталитический распад H_2O_2 в гидрофильных растворителях: кинетический аспект // Журнал прикладной химии — 2007. — Т.80. Вып. 11 — С.1797 — 1800.
- Micho V.V., Vilinskaya L.N., Koleboshin V.Ya. Phenomena arising by interaction of metal oxide with water and ammonia vapours // Workshop sensors springtime in Odessa. Satellite of EVROSENSORS, Satellite of NEXUSPAN 29-30 may 1998, Odessa (Ukraine). — 50 p.
- Танабе К. Твердые кислоты и основания. М., 1973 — 176с.